

2SA1135

シリコンPNPエピタキシャルメサ形トランジスタ

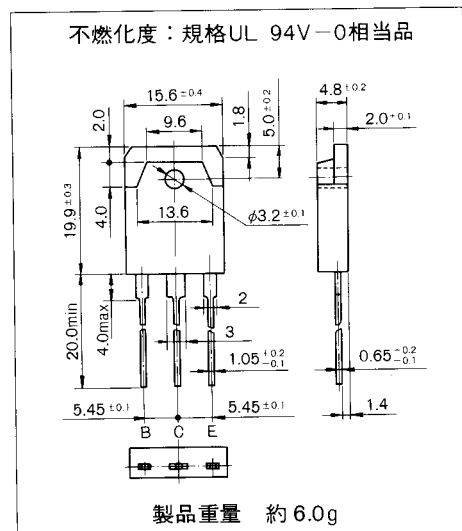
☆2SC2665とコンプリメンタリペアになります。

☆レジンモールドケース

○一般用

外形図

単位：mm



最大定格 (Ta=25°C)

| 項目 | 記号 | 2SA1135 | 単位 |
|-------------|------------------|----------------|----|
| コレクタ・ベース電圧 | V _{CB0} | -80 | V |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V _{CE0} | -80 | V |
| エミッタ・ベース電圧 | V _{EB0} | -6 | V |
| コレクタ電流 | I _C | -4 | A |
| ベース電流 | I _B | -1 | A |
| 許容コレクタ損失 | P _C | 55(フランジ温度25°C) | W |
| 接合温度 | T _j | 150 | °C |
| 保存温度 | T _{stg} | -55~+150 | °C |

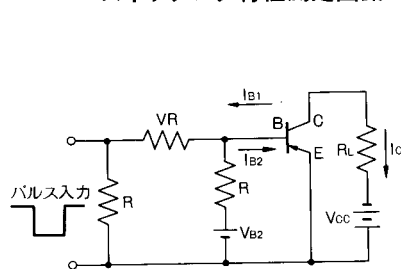
電気的特性 (Ta=25°C)

| 項目 | 記号 | 試験条件 | 2SA1135 | 単位 |
|---------------|----------------------|---|----------|-----|
| 最大コレクタ遮断電流 | I _{CB0} | V _{CB} = -80V | -1 | mA |
| 最大エミッタ遮断電流 | I _{EB0} | V _{EB} = -6V | -1 | mA |
| コレクタ・エミッタ降伏電圧 | V _{(BR)CEO} | I _C = -25mA | -80 | V |
| 直流電流増幅率 | h _{FE} | V _{CE} = -4V I _C = -1A | 40 min | |
| コレクタ飽和電圧 | V _{CE(sat)} | I _C = -2A I _B = -0.2A | -1.0 max | V |
| 遮断周波数 | f _T | V _{CE} = -10V I _E = 0.2A | 10 typ | MHz |

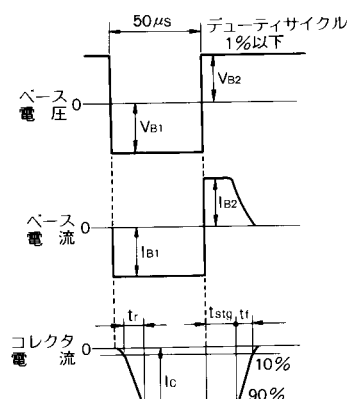
代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

| V _{CC} (V) | R _L (Ω) | I _C (A) | V _{B2} (V) | I _{B1} (mA) | I _{B2} (mA) | t _r (μs) | t _{stg} (μs) | t _f (μs) |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| -6 | 3 | -2 | 5 | -300 | 300 | 1.0typ | 0.4typ | 0.15typ |

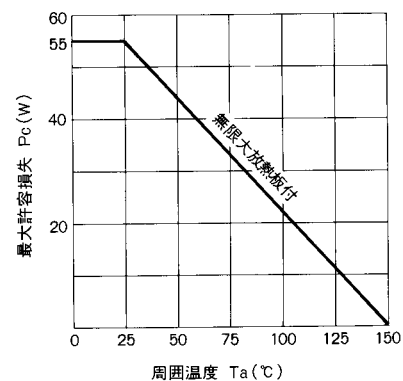
スイッチング特性測定回路



測定波形



P_C-T_a 定格



This datasheet has been downloaded from:

www.DatasheetCatalog.com

Datasheets for electronic components.